(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-147764 (P2000-147764A)

(43)公開日 平成12年5月26日(2000.5.26)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマコード( <del>参考</del> )
G03F	7/032		G 0 3 F	7/032		2H025
	7/023	511		7/023	511	
	7/038	601		7/038	601	
H01L	21/027		H01L	21/30	502R	

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

		一 一	木明水 明水丸の数3 OL (主 / 頁)
(21)出願番号	特願平10-317971	(71)出願人	397040605
			クラリアント ジャパン 株式会社
(22)出願日	平成10年11月9日(1998.11.9)		東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京
			グリーンコート センターオフィス 9 階
		(72)発明者	小林 聡
			静岡県小笠郡大東町千浜3810 クラリアン
			トジャパン株式会社内
		(72)発明者	塩田 英和
			静岡県小笠郡大東町千浜3810 クラリアン
			トジャパン株式会社内
		(74)代理人	100108350
			弁理士 鐘尾 宏紀 (外1名)
			最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

# (57)【要約】

【課題】本発明は、良好なパターンを形成することができ、特に基板に対する高い密着性を有し、かつポストベーク後においても剥離液により容易に溶解除去される感放射線性樹脂組成物を提供する。

【構成】キノンジアジドーノボラックタイプのポジ型感放射線性樹脂組成物および化学増幅型ネガ型感放射線性 樹脂組成物等のアルカリ可溶性樹脂含有感放射線性樹脂 組成物中のアルカリ可溶性樹脂として、下記一般式

(I)で表される化合物と必要に応じフェノール類と を、アルデヒド化合物により重縮合することにより得ら れるアルカリ可溶性樹脂を用いる。

【化】



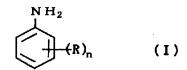
(式中、R は水酸基または炭素数  $1 \sim 4$  のアルキル基を表し、n は 0 または  $1 \sim 3$  の整数を表し、n が 2 または

3のときには、各Rは同一でも異なるものでもよい。)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】アルカリ可溶性樹脂を含有する感放射線性 樹脂組成物において、該アルカリ可溶性樹脂が、少なく とも、下記一般式(I)で表される化合物を単量体の一 成分とするアルカリ可溶性樹脂を含むものであることを 特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【化1】



(式中、Rは水酸基または炭素数  $1\sim 4$ のアルキル基を表し、nは 0 または  $1\sim 3$  の整数を表し、n が 2 または 3 のときには、4 名 化同一でも異なるものでもよい。) 【請求項 2 】請求項 1 記載の感放射線性樹脂組成物において、アルカリ可溶性樹脂が上記一般式(1)で表される化合物とフェノール類とをホルマリンなどのアルデヒド類で重縮合することにより得られるものを含むことを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【請求項3】請求項1記載の感放射線性樹脂組成物において、上記一般式(I)で表される化合物の割合が全アルカリ可溶性樹脂中において0.1~40重量%であることを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

# 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体デバイスや 液晶表示装置等を製造するための、さらに詳しくは、良 好なパターンを形成し、特に基板との密着性に優れ、か つ剥離液で容易に除去することのできる感放射線性樹脂 組成物に関するものである。

# [0002]

【従来の技術】従来からICやLSIなどの半導体デバイスや液晶表示装置などの製造プロセスにおいては、シリコン基板やアルミニウム、モリブデン、クロムなどの金属膜基板、またITOなどの金属酸化膜基板上に感放射線性樹脂(フォトレジスト)の薄膜を形成し、このフォトレジスト膜をマスクパターンを介して紫外線などにより照射した後現像し、得られたフォトレジストのパターンをマスクとして基板をエッチングすることにより微細パターンを形成することが行われている。

【0003】従来このようなフォトリソグラフィーにおいて用いられる感放射線性樹脂組成物としては種々のものが提案されており、一例を挙げると、ポジ型では、アルカリ可溶性ノボラック樹脂と感光成分であるキノンジアジド基含有化合物を組み合わせたもの(特開平7-120914)、ネガ型では、アルカリ可溶性ノボラック樹脂と架橋剤としてアルコキシメチル化メラミン、酸発生剤としてハロゲン化トリアジンを組み合わせたもの

(特開平5-303196) などがある。ところで、フ 50 る。すなわち、本発明は、アルカリ可溶性樹脂を含有す

オトレジストを用いて基板を精度よくエッチングするためには、レジストパターンと基板との高い密着性が要求される。レジストパターンと基板との密着性を改善する方法として、プロセス的には、現像により得られたフォトレジストのパターンをベーク(加熱処理)する、いわゆるポストベークが提案され、実施されている。また、材料面からはベンゾイミダゾール類、ポリベンゾイミダゾール類などの密着性向上剤をポジ型フォトレジストに含有させる(特開平6-27657)、或いはベンゾト10リアゾール類をネガ型フォトレジストに含有させる(特開平8-339087)など、感放射線性樹脂組成物に密着性向上剤を添加することが提案されている。

2.

【0004】しかしながら、レジストと基板との密着性 改善のためにポストベークを行った場合、特にネガ型フ オトレジストでは、このポストベークによりその後のフ オトレジストの剥離が困難になることは広く知られてい る。また、ポジ型レジストでは一般的にフォトレジスト が剥離液に溶解しながら剥離されていくのに対して、ネ ガ型レジストでは通常フォトレジストが膨潤し、溶解せ 20 ずに剥がれるように剥離されるが、このように剥がれる ようにフォトレジストが剥離されると、これらが基板に 再付着してパターン欠陥の原因ともなるという問題もあ る。また、特にITO (Indium Tin Oxi de) などの基板は、空気中のアミン等の塩基性成分を 吸収し、これにより、露光によってフォトレジスト中に 発生した酸が失活し、フォトレジストと基板の界面でパ ターンに食い込みが生じるという問題がある。そこで、 良好なレジストパターンを形成することができると共 に、基板に対する高い密着性を有し、かつ剥離液等に容 30 易に溶解し得る高い剥離性を有するフォトレジストが望 まれていた。

### [0005]

【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明は、アルカリ可溶性樹脂を含有するネガ型或いはポジ型感放射線性樹脂組成物のいずれの場合においても、シリコン基板、金属膜基板および金属酸化膜基板などの基板上に、アンダーカットやフッティングがなく良好なパターンを形成することができ、密着性向上のために現像後の加熱処理をおこなった後でも剥離液により容易に溶解剥離させることのできる感放射線性樹脂組成物を提供することを目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、鋭意検討 の結果、アルカリ可溶性樹脂を含有する感放射線性樹脂 組成物に、アルカリ可溶性樹脂として、下記一般式

(I)で表される化合物を単量体の一成分とするアルカリ可溶性樹脂(以下、「アニリン変成樹脂」ともいう。)を含有せしめることにより上記目的を達成することができることを見い出して、本発明を成したものである。 オなわた 本発明は、アルカル可溶性 関係も今ださ

る感放射線性樹脂組成物において、該アルカリ可溶性樹脂が、少なくとも、下記一般式(I)で表される化合物を単量体の一成分とするアルカリ可溶性樹脂を含むものであることを特徴とする感放射線性樹脂組成物である。 【化2】

$$(I)$$

(式中、Rは水酸基または炭素数1~4のアルキル基を表し、nは0または1~3の整数を表し、nが2または3のときには、各Rは同一でも異なるものでもよい。)【0007】本発明で用いられるアニリン変成樹脂としては、上記一般式(I)で表わされる化合物とフェノール類とを、ホルマリンなどのアルデヒド類で重縮合することによって得られるものが最も好ましいものであるので、この重縮合アニリン変性樹脂を含有する感放射線性樹脂組成物について、以下本発明を更に詳細に説明する。

【0008】まず、アニリン変成樹脂を構成する単量体成分として用いられる、一般式(I)で表わされる化合物としては、アニリン、2、3ージメチルアニリン、2、4ージメチルアニリン、3、4ージメチルアニリン、3、5ージメチルアニリン、3、5ージメチルアニリン、2、6ージイソプロピルアニリン、3、5ージーtertーブチルアニリン、2、4、6ートリメチルアニリン、2、4、6ートリーはertーブチルアニリン等が挙げられる。これらの化合物は、単独で或いは2種以上の混合物として用いることができる。

【0009】また、上記重縮合樹脂の原料として用いら れるフェノール類としては、従来アルカリ可溶性樹脂を 形成するために用いられていたフェノール類のいずれを も用いることができる。これらフェノール類を具体的に 例示すると、フェノール、p-クレゾール、m-クレゾ ール、o-クレゾール、2,3-ジメチルフェノール、 2, 4-ジメチルフェノール、2, 5-ジメチルフェノ ール、2,6-ジメチルフェノール、3,4-ジメチル フェノール、3,5-ジメチルフェノール、2,3,4 ートリメチルフェノール、2,3,5ートリメチルフェ ノール、3,4,5-トリメチルフェノール、2,4, 5-トリメチルフェノール、メチレンビスフェノール、 メチレンビスpークレゾール、レゾルシン、カテコー ル、2-メチルレゾルシン、4-メチルレゾルシン、o -クロロフェノール、m-クロロフェノール、p-クロ ロフェノール、2,3-ジクロロフェノール、m-メト キシフェノール、p-メトキシフェノール、p-ブトキ シフェノール、o-エチルフェノール、m-エチルフェ ノール、p-エチルフェノール、2,3-ジエチルフェ ノール、2, 5 – ジエチルフェノール、p – イソプロピルフェノール、 $\alpha$  – ナフトール、 $\beta$  – ナフトールなどが挙げられる。これらの化合物は、単独でまたは 2 種以上を組み合わせて用いることができる。

4

【0010】更に、アルデヒド類としては、ホルマリンの他、パラホルムアルデヒデド、アセトアルデヒド、ベンズアルデヒド、ヒドロキシベンズアルデヒド、クロロアセトアルデヒドなどを単独または複数の混合で用いることができる。

- 0 【0011】本発明で用いられる重縮合アニリン変成樹脂は、公知のノボラック型フェノール樹脂と同様の方法、すなわちフェノール類等とアルデヒド類とを酸触媒共存下で昇温し、反応させることにより容易に得ることができる。具体的には、本発明に係るアニリン変性樹脂は、通常フェノール類100重量部に対して、一般式(I)で表される化合物0.1~60重量部、アルデヒド類10~20重量部、蓚酸1~3重量部の割合で混合し、反応温度85~95℃で最低4時間反応させることにより製造される。
- 20 【0012】また、本発明に係るアニリン変性樹脂としては、重量平均分子量が500~10,000、好ましくは1,000~5,000のものを好適に使用できる。

【0013】得られたアニリン変成樹脂は単独であるいはアニリン未変成の従来公知のアルカリ可溶性樹脂と組み合わせて使用することができる。アニリン変成樹脂とともに用いることができるアルカリ可溶性樹脂としては、上記フェノール類の少なくとも1種と、アルデヒド類の少なくとも1種との重縮合により得られるノボラック樹脂が好ましい。一般式(I)で表わされる化合物の全アルカリ可溶性樹脂中の含有量は、0.1~40重量%が好ましく、更に好ましくは、1~30重量%である

【0014】本発明のアニリン変成樹脂を含有する感放射線性樹脂組成物は、ポジ型或いはネガ型のいずれのものでもよい。ポジ型感放射線性樹脂組成物としては、感光剤としてキノンジアジド基を含む化合物を用いる、いわゆるキノンジアジドーノボラックタイプの感放射線性樹脂組成物が代表的なものとして挙げられる。このキノンジアジドーノボラックタイプの感放射線性樹脂組成物には、アルカリ可溶性樹脂として、上記重縮合アニリン変性樹脂、及び、必要に応じノボラック樹脂のようなキノンジアジドーノボラック系レジストで用いられている公知のアルカリ可溶性樹脂が用いられる。

【0015】また、キノンジアジド基を含む感光剤としては、従来キノンジアジドーノボラック系レジストで用いられている公知の感光剤のいずれのものをも用いることができる。この感光剤としては、ナフトキノンジアジドスルホン酸クロリドやベンゾキノンジアジドスルホン50 酸クロリドと、この酸クロリドと縮合反応可能な官能基

を有する低分子化合物または高分子化合物とを反応させ ることによって得られた化合物が好ましい。ここで酸ク ロリドと縮合可能な官能基としては水酸基、アミノ基等 が挙げられるが、特に水酸基が好適である。水酸基を含 む酸クロリドと縮合可能な化合物としては、例えば、ハ イドロキノン、レゾルシン、2.4-ジヒドロキシベン ゾフェノン、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノ ン、2、4、6-トリヒドロキシベンゾフェノン、2、 4, 4'ートリヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 4, 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、2, 2', 4, 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、 2, 2', 3, 4, 6'-ペンタヒドロキシベンゾフェ ノン等のヒドロキシベンゾフェノン類、ビス(2,4-ジヒドロキシフェニル) メタン、ビス(2,3,4-ト リヒドロキシフェニル)メタン、ビス(2,4-ジヒド ロキシフェニル)プロパン等のヒドロキシフェニルアル カン類、4,4',3",4"-テトラヒドロキシー 3. 5, 3', 5'ーテトラメチルトリフェニルメタ ン、4,4',2",3",4"-ペンタヒドロキシー 3, 5, 3', 5'ーテトラメチルトリフェニルメタン 等のヒドロキシトリフェニルメタン類等を挙げることが できる。これらは単独で用いてもよいし、また2種以上 を組合わせて用いてもよい。キノンジアジド基を含む感 光剤の配合量は、アルカリ可溶性樹脂100重量部当た り、通常5~50重量部、好ましくは、10~40重量 部である。

【0016】本発明のネガ型感放射線性樹脂組成物の代 表的なものとしては、アルカリ可溶性ベース樹脂、架橋 剤、酸発生剤から成る3成分系化学増幅型ネガ型レジス トが挙げられる。まず、アルカリ可溶性ベース樹脂とし ては、上記重縮合アニリン変性樹脂及び必要に応じノボ ラック樹脂のような従来3成分系化学増幅型ネガ型レジ ストでアルカリ可溶性ベース樹脂として用いられている ものが用いられる。

【0017】また、この化学増幅型ネガ型レジストの架 橋剤としては、従来化学増幅型ネガ型レジストの架橋剤 として用いられているものはいずれのものをも用いるこ とができる。架橋剤の例としては、メラミン系、グアナ ミン系および尿素系低分子誘導体のほかに、アルコキシ アルキル化メラミン樹脂、アルコキシアルキル化ベンゾ グアナミン樹脂、アルコキシアルキル化尿素樹脂などの アルコキシアルキル化アミノ樹脂を好ましいものとして 挙げることができる。これらアルコキシアルキル化アミ ノ樹脂の具体例としては、メトキシメチル化メラミン樹 脂、エトキシメチル化メラミン樹脂、プロポキシメチル 化メラミン樹脂、ブトキシメチル化メラミン樹脂、エト キシメチル化ベンゾグアナミン樹脂、メトキシメチル化 尿素樹脂、エトキシメチル化尿素樹脂、ブロポキシメチ ル化尿素樹脂、ブトキシメチル化尿素樹脂などが挙げら れる。また、メラミン系、グアナミン系および尿素系低 50 コールモノアルキルエーテルアセテート類、乳酸メチ

分子誘導体としては、メトキシメチル化メラミン、エト キシメチル化メラミン、ブロポキシメチル化メラミン、 ブトキシメチル化メラミン、ヘキサメチロールメラミ ン、アセトグアナミン、ベンゾグアナミン、メチル化ベ ンゾグアナミン、モノメチロール尿素、ジメチロール尿 素が挙げられる。これらの中でもメラミン系、ベンゾグ アナミン系低分子誘導体、アルコキシアルキル化ベンゾ グアナミン樹脂、アルコキシアルキル化メラミン樹脂が 好ましい。これら架橋剤は、単独でまたは2種以上混合 10 して使用することができ、その配合量は、アルカリ可溶 性樹脂100重量部当たり、通常2~50重量部、好ま しくは、5~30重量部である。

【0018】また、酸発生剤としては、オニウム塩で は、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ジアゾニウム 塩、アンモニウム塩、ピリジニウム塩等が、ハロゲン含 有化合物では、ハロアルキル基含有炭化水素化合物、ハ ロアルキル基含有複素環式化合物等が、ジアゾケトン化 合物では、1,3-ジケト-2-ジアゾ化合物、ジアゾ ベンゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等が、 スルホン化合物では、 $\beta$  - ケトスルホン、 $\beta$  - スルホニ ルスルホン等が、スルホン酸化合物では、アルキルスル ホン酸エステル、ハロアルキルスルホン酸エステル、ア リールスルホン酸エステル、イミノスルホナート等が挙 げられる。これらの酸発生剤は、単独でまたは2種以上 混合して使用することができ、その配合量は、アルカリ 可溶性樹脂100重量部当たり、通常0.1~10重量 部、好ましくは、0.5~5.0重量部である。

【0019】更に、化学増幅型ネガ型レジストには、添 加剤として塩基性化合物を配合することが好ましい。こ の塩基性化合物は、露光により酸発生剤から生じた酸の レジスト膜中における拡散現象を制御し、解像度を向上 させたり、露光裕度等を向上させることができる。この ような塩基性化合物としては、第1級、第2級、第3級 の脂肪族アミン類、芳香族アミン類、複素環アミン類、 アルキル基、アリール基などを有する窒素化合物、アミ ド基またはイミド基含有化合物等を挙げることが出来

【0020】本発明のポジ型およびネガ型感放射線性樹 脂組成物を溶解させる溶剤としては、エチレングリコー ルモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチル エーテル等のエチレングリコールモノアルキルエーテル 類、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート 等のエチレングリコールモノアルキルエーテルアセテー ト類、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ブロ ピレングリコールモノエチルエーテル等のプロピレング リコールモノアルキルエーテル類、プロピレングリコー ルモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート等のプロピレングリー

ル、乳酸エチル等の乳酸エステル類、トルエン、キシレ ン等の芳香族炭化水素類、メチルエチルケトン、2-ヘ プタノン、シクロヘキサノン等のケトン類、N,Nージ メチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン等のアミド 類、γープチロラクトン等のラクトン類等を挙げること ができる。これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を混 合して使用される。

【0021】本発明の感放射線性樹脂組成物には、必要 に応じ染料、接着助剤および界面活性剤等を配合するこ とができる。染料の例としては、メチルバイオレット、 クリスタルバイオレット、マラカイトグリーン等が、接 着助剤の例としては、アルキルイミダゾリン、酪酸、ア ルキル酸、ポリヒドロキシスチレン、ポリビニルメチル エーテル、t-ブチルノボラック、エポキシシラン、エ ポキシポリマー、シラン等が、界面活性剤の例として は、非イオン系界面活性剤、例えばポリグリコール類と その誘導体、すなわちポリブロピレングリコールまたは ポリオキシエチレンラウリルエーテルなど、フッ素含有 界面活性剤、例えばフロラード(商品名、住友3M社 製)、スルフロン(商品名、旭ガラス社製)、または有 機シロキサン界面活性剤、例えばKP341(商品名、 信越化学工業社製)が挙げられる。

[0022]

【実施例】以下に本発明をその実施例をもって説明する が、本発明の態様はこれらの実施例に限定されるべきも のではない。

【0023】合成例1(アニリン変成樹脂Aの合成) m-クレゾール/p-クレゾールを6/4の比率で混ぜ た混合クレゾール100重量部に対し、アニリン20重 量部、37重量%ホルムアルデヒド45重量部、蓚酸 1.8重量部の割合で仕込み、反応温度90℃で4時間 反応させた。このアニリン変成樹脂Aの分子量はボリス チレン換算で1,800であつた。

合成例2 (アニリン変成樹脂Bの合成)

混合クレゾール100重量部に代えて、o-クレゾール 100重量部を用いる外は合成例1と同様にして、アニ リン変成樹脂Bを得た。

【0024】実施例1~3

m、p-クレゾールノボラック樹脂(m-クレゾール/ p-クレゾール=6/4、ポリスチレン換算重量平均分

子量10,000)、感光剤として2,3,4-トリハ イドロキシベンゾフェノン-o-ナフトキノン-1.2 ジアジドスルホン酸トリエステル、合成例1で得られ たアニリン変性樹脂Aを各々表1の比率でプロピレング リコールモノメチルエーテルアセテートに溶解した後、 テフロン(登録商標)製の0.2μmメンブランフィル ターでろ過し、本発明のポジ型フォトレジスト組成物を 調製した。この組成物をITO膜付き4インチシリコン ウェハー上に回転塗布し、100℃、90秒間ホットブ 10 レートにてベークし、1.  $5 \mu$  m厚のレジスト膜を得 た。このレジスト膜にGCA社製g線ステッパー(DS W6400、NA=0.42)にて露光を行った後、 0.9重量%水酸化カリウム水溶液により、60秒間現 像を行い、パターンの形成を行った。ここで得られたパ ターンをマスクとして、塩酸と塩化第二鉄の混合液によ りエッチングを行い、シリコンウェハー上にレジスト付 きITOのパターンを形成した。ここでエッチング時間 は、レジストが塗布されていないITO基板をエッチン グ液に浸漬し、ITO膜が完全にエッチングされて取り 製)、メガファック(商品名、大日本インキ化学工業社 20 除かれる時間、すなわちジャストエッチ時間とした。エ ッチング後、走査型電子顕微鏡 (SEM) にて5μmの ラインパターンの形状の観察を行った。また、一般に現 像後、ポストベークを行うと基板との密着性が向上す る。そこで、現像後エッチング前に130℃、3分間の ポストベークを行った後に、前記同様エッチング処理を 行い、SEMにてラインパターンの形状を観察した。結 果を表1に示す。アニリン変成樹脂の添加により、ポス トベークを行わなくてもアンダーカットを低減すること ができるあるいはアンダーカットをほとんどなくすこと 30 ができること、またポストベークを行なうことにより、 確実にアンダーカットをなくすことができることが分か

8

# 【0025】比較例1

アニリン変性樹脂を添加しないことを除き実施例1を繰 り返し行い、エッチング後のラインパターンの形状を観 察した。結果を表1に示す。現像後ポストベークを行わ ない場合には、大きなアンダーカットが観察された。ま た現像後ポストベークを行った場合にも、アンダーカッ トは低減されたものの、なくすことはできなかった。

[0026]

【表 1 】

	/ポラック樹脂/感光剤	ア=リン変成樹脂 A		ラインパターンの形状 (ポストペークあり)
実施例1	100/15	5	Δ	0
実施例2	100/15	. 10	0	0
実施例3	100/15	15	0	0
比較例1	100/15	0	×	Δ

〇: アンダーカットほとんどなし Δ: アンダーカット低減 ×: アンダーカットあり

【0027】 実施例4~6

実施例1~3と同様にしてパターンの形成を行った。パ 実施例1~3で得られたフォトレジスト組成物を用い、 50 ターン形成後各々のパターンを実施例1~3と同様にし

てエッチングした後、剥離液としてリムーバー100 (クラリアントジャパン社製)を用い、35℃で浸積法 にて300秒間レジストの剥離処理をした。また、現像 後に130、150、170℃の温度で各々5分間のポ ストベークを行った以外は同様にして剥離処理を行っ た。これらの結果を、表2に示す。ポストベークを行わ ない場合および現像後に130、150、170℃の温 度で各々5分間のポストベークを行った後場合のいずれ においても、フォトレジストは溶解しながら剥離され

比較例 1 と同様にフォトレジスト組成物を調製し、同様 にパターン形成を行った。実施例4と同様に、エッチン グ後、剥離処理を行った結果、および現像後各130、 150、170℃のポストベークを行った後、エッチン グ、剥離処理を行った結果を表2に示す。ポストベーク を行った場合は所定時間内に剥離されず、剥離時間を延 長すると、溶解しながらではなく剥がれるように剥離さ れた。

10

[0029]

【表 2 】 10

#### 【0028】比較例2

	/4*ラック樹脂/感光剤	アニリン変成樹脂	ポストベークなし	130℃	150℃	170℃
実施例4	100/15	5	0	0	0	×
実施例5	100/15	10	0	0	0	0
実施例6	100/15	15	0	0	0	0
比較例2	100/15	0	0	×	×	×

〇:溶解剥離可 ×:溶解剥離不可

[0030]

#### 実施例7

m、p-クレゾールノボラック樹脂 100重量部  $(m-\rho\nu)/(p-\rho\nu)/(m-\rho)/(4)$ ポリスチレン換算重量平均分子量4000) エトキシメチル化ベンゾグアナミン樹脂 25重量部

2, 4, 6-トリス (トリクロロメチル) トリアジン 3重量部 合成例1のアニリン変性樹脂A 20重量部

水酸化テトラブチルアンモニウム

0.5重量部

をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート に溶解した後、テフロン製の0.2μmメンブランフィ ルターでろ過し、ネガ型フォトレジスト組成物を調製し た。

【0031】この組成物をITO膜付き4インチシリコ ンウェハー上に回転塗布し、100℃、90秒間ホット プレートにてベーク後、1.5μm厚のレジスト膜を得 た。このレジスト膜にGCA社製g線ステッパー(DS W6400, NA=0.42) にて露光を行った後、1 30℃で90秒間PEB(ポスト・エクスポージャー・ ベーク)を行い、2.38重量%水酸化テトラメチルア ンモニウム水溶液により60秒間現像を行い、パターン の形成を行った。また、ここで得られたパターンをマス クとして、塩酸と塩化第二鉄の混合液によりエッチング を行い、シリコンウェハー上にレジスト付きITOのパ ターンを形成した。エッチングの前後に、走査型電子顕 微鏡 (SEM) にて5μmのラインパターンの形状を観 察したところ、アンダーカットのほとんどない良好なパ ターンが観察された。また、現像後に140℃、3分間 のポストベーク処理を行った場合はさらに良好なパター ンが観察された。次に、形成したパターンを剥離液であ るリムーバー100(クラリアントジャパン社製)を用 い、23℃で浸積法にて60秒間レジストの剥離処理を

したところ、溶解しながら剥離された。また、現像後に

140℃、3分間のポストベークを行った後、同様に剥 離処理を行ってもフォトレジストは溶解しながら剥離さ れた。

#### 【0032】実施例8 30

合成例2で得られたアニリン変成樹脂Bを用いる以外は 実施例7と同様にしてフォトレジストを調整し、ライン パターンの形成、エッチング、エッチング前後のライン パターンの形状の観察を行った。また、実施例7同様 に、形成したパターンの剥離処理をしたところ、溶解し ながら、剥離された。また、現像後に140℃、3分間 のポストベークを行った後、同様に剥離処理を行っても フォトレジストは溶解しながら剥離された。

# 【0033】比較例3

40 アニリン変成樹脂を添加しないこと以外は実施例7と同 様にしてフォトレジスト組成物を調整し、同様にライン パターンの形成、エッチング、エッチング前後のライン パターンの形状を観察を行ったところ、大きなアンダー カットが観察された。また実施例7同様、現像後にポス トベークを行っても、アンダーカットを完全に抑制する ことはできなかった。さらに、実施例7同様、形成した ラインパターンを剥離処理したところ、剥離することが できなかった。剥離時間を延長すると、剥がれるように 剥離され、未溶解フォトレジスト残渣が浮遊していた。 50 以上の実施例7、8および比較例3結果をまとめ、表3

12

に示す。

[0034]

【表3】

<del>-</del>		ラインパーク	アン形状		記れ版をよりを持ち	
	エッチング 前+1		エッチング 後*2		<b>列雕状態</b>	
ポストペークの有無	なし	あり	なし	あり	なし	あり、
実施例7	0	0	Δ	0	溶解剥離可	溶解剝離可
実施例8	0	0	Δ	0	溶解剥雕可	溶解剥離可
比較例3	×	Δ	×	Δ	溶解剥離不可	溶解剝離不可

\*1 エッチンク<sup>\*</sup>前

〇:パターンの食い込みなし X:パターンの食い込みあり △:パターンの食い込み低減

\*2 エッチング後

〇:アンダーカゥトなし

△: アンタ゚ーカット低減 ×: アンタ゚ーカットあり

[0035]

【発明の効果】本発明は、良好なパターンを形成することができ、また特に基板に対する高い密着性を有し、かつ剥離液により剥がれ型の剥離ではなく、溶解剥離によ

り容易に除去することができる感放射線性樹脂を提供することができ、この感放射線性樹脂組成物は半導体デバイスや液晶表示の製造において好適に使用することができる。

# フロントページの続き

(72)発明者 伊藤 晴彦

東京都八王子市高倉町52-18 パーシモン ヒルズ 403 Fターム(参考) 2H025 AA03 AA14 AA16 AB16 AB17 AC01 AD01 AD03 BE00 BE01 CB19 CB28 CB45 CB47 CB52 CC17 FA48